

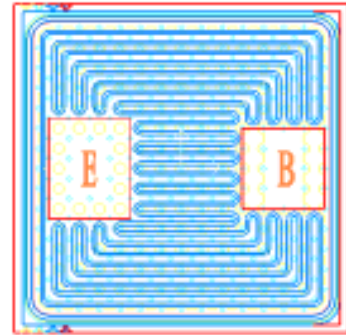


1357 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：A126AG-00
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：1260 × 1260μm²
 焊位尺寸：B 极 308×308μm²；E 极 308×385μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：2SA1357，H1357

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-126)

T _{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T _j ——结温.....	150
P _C ——集电极功率耗散(T _c =25).....	10W
P _C ——集电极功率耗散(T _a =25).....	1.5W
V _{CBO} ——集电极—基极电压.....	-40V
V _{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V _{EBO} ——发射极—基极电压.....	-8V
I _C ——集电极电流(DC).....	-5A
I _C ——集电极电流(脉冲).....	-8A
I _B ——基极电流.....	-1A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-126)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{(BR)CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	I _C =-10mA, I _B =0
I _{CBO}	集电极—发射极截止电流			-100	nA	V _{CE} =-40V, I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V _{EB} =-8V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	140		600		V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
		70				V _{CE} =-2V, I _C =-4A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1.0	V	I _C =-4A, I _B =-100mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压			-1.5	V	V _{CE} =-2V, I _C =-4A
f _T	特征频率		170		MHz	V _{CE} =-2V, I _E =-500mA
C _{ob}	共基极输出电容		60		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz

Pulse Test: PW=10mS(max), Duty Cycle=30%(min)